エ　酸化エルビウム
オ　酸化ハフニウム
カ　酸化マグネシウム
キ　ニオブ、チタン及びタングステンからなる合金であって、窒化したもの
ク　酸化イットリウム
ケ　酸化ジルコニウム
⑵　容量が0.05リットル超２リットル未満のるつぼであって、重量比による純度が99.9パーセント以上のタンタル製のもの又はそのタンタルで裏打ちされたもの
⑶　容量が0.05リットル超２リットル未満のるつぼであって、重量比による純度が98パーセント以上のタンタル製のもの又はそのタンタルで裏打ちされたもののうち、タンタルの炭化物、窒化物、ほう化物又はこれらのいずれかを組み合わせたもので被覆されたもの
26　ハフニウム若しくはハフニウム合金（ハフニウムの含有量が全重量の60パーセントを超えるものに限る。）の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物（ハフニウムの含有量が全重量の60パーセントを超えるものに限る。）又はこれらの半製品若しくは一次製品
27　リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、リチウム６のリチウム６及びリチウム７に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたリチウムから構成されるもの又はそのリチウムを含むもの（熱ルミネセンス線量計に組み込まれたリチウム化合物又はリチウム混合物を除く。）
28　タングステン、タングステンの炭化物又はタングステンの含有量が全重量の90パーセントを超える合金であって、質量が20キログラムを超え、かつ、内径が100ミリメートル超300ミリメートル未満の円筒形のもの若しくは中空の半球形のもの又はこれらを組み合わせたもの（おもり又はガンマ線のコリメータ用に設計されたものを除く。）
29　ジルコニウム若しくはジルコニウム合金（ジルコニウムの含有量が全重量の50パーセントを超えるものに限る。）の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物（ハフニウムの含有量がジルコニウムの含有量の500分の１未満のものに限る。）又はこれらの半製品若しくは一次製品（厚さが0.1ミリメートル以下のはくを除く。）
30　フッ素製造用の電解槽
31　ガス遠心分離機のローターの製造用若しくは組立てに用いられる装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
⑴　ガス遠心分離機のローターのチューブ、バッフル及びエンドキャップの組立用の装置
⑵　ガス遠心分離機のローターのチューブの中心軸を調整するための装置
⑶　ベローズ製造用の装置又は型
32　遠心力式釣合い試験機（一面釣合い試験機を除く。）
33　フィラメントワインディング装置であって、次の⑴及び⑵に該当するもの又はその部分品若しくはその制御装置若しくはマンドレル
⑴　繊維を位置決めし、包み及び巻く作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が２以上のもの
⑵　次のいずれかに該当するもの
ア　内径が75ミリメートル超650ミリメートル未満であって、かつ、長さが300ミリメートル以上の円筒形のチューブを製造することができるもの
イ　次の㋐及び㋑に該当するもの
㋐　複合材料からなる構造体を製造するため、又は繊維状の物質をラミネートするために特に設計したもの
㋑　直径が75ミリメートル以上の円筒形の管を製造することができるもの
34　ウランの同位元素の分離に用いられるガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの（７に該当するものを除く。）
⑴　500ナノメートル超600ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した金属蒸気レーザー発振器（銅レーザー発振器に限る。）であって、平均出力が30ワット以上のもの
⑵　400ナノメートル超515ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアルゴンイオンレーザー発振器であって、平均出力が40ワットを超えるもの
⑶　9,000ナノメートル超11,000ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した二酸化炭素レーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次のアからウまでの全てに該当するもの
ア　パルス繰返し周波数が250ヘルツを超えるもの
イ　平均出力が500ワットを超えるもの
ウ　パルス幅が200ナノ秒未満のもの
⑷　240ナノメートル超360ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したエキシマレーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次のア及びイに該当するもの
ア　パルス繰返し周波数が250ヘルツを超えるもの
イ　平均出力が500ワットを超えるもの
⑸　16マイクロメートルの波長で用いるように設計したパラ水素を用いたラマンレーザー発振器であって、パルス繰返し周波数が250ヘルツを超えるもの
⑹　720ナノメートル超800ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアレキサンドライトレーザー発振器であって、次のアからウまでの全てに該当するもの
ア　パルス繰返し周波数が125ヘルツを超えるもの
イ　平均出力が30ワットを超えるもの
ウ　レーザー光のスペクトル線幅が0.005ナノメートル以下のもの
⑺　1,000ナノメートル超1,100ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したネオジムを添加した固体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの（ネオジムガラスレーザー発振器を除く。）
ア　パルス励起及びキュースイッチを用いたものであって、１ナノ秒以上のパルス幅のパルスを発振するもののうち、次のいずれかに該当するもの
㋐　単一横モードのパルスを発振するものであって、平均出力が40ワットを超えるもの
㋑　多重横モードのパルスを発振するものであって、平均出力が50ワットを超えるもの
イ　波長範囲が500ナノメートル超550ナノメートル未満で、かつ、平均出力が40ワットを超える第二高調波を発生するように設計したもの
⑻　300ナノメートル超800ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
ア　単一モードのパルスを発振する波長可変レーザー発振器（レーザー光の増幅のみを行う装置を除く。）であって、次の㋐から㋒までの全てに該当するもの
㋐　パルス繰返し周波数が１キロヘルツを超えるもの
㋑　平均出力が１ワットを超えるもの
㋒　パルス幅が100ナノ秒未満のもの
イ　パルスを発振する波長可変レーザー発振器であって、次の㋐から㋒までの全てに該当するもの（アに該当するものを除く。）
㋐　パルス繰返し周波数が１キロヘルツを超えるもの
㋑　平均出力が30ワットを超えるもの
㋒　パルス幅が100ナノ秒未満のもの
⑼　5,000ナノメートル超6,000ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した一酸化炭素レーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次のアからウまでの全てに該当するもの（産業用のものを除く。）
ア　パルス繰返し周波数が250ヘルツを超えるもの
イ　平均出力が200ワットを超えるもの
ウ　パルス幅が200ナノ秒未満のもの